

### Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Чесницкого Антона Васильевича «Разработка и исследование магнитооптических и трехосевых холловских датчиков», представленной в диссертационный совет Д.212.173.03 при Новосибирском государственном техническом университете на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальностям 01.04.10 – «Физика полупроводников» и 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах»

Фамилия, имя, отчество	Айзенштат Геннадий Исаакович
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень	Доктор технических наук, 01.04.10
Основное место работы	
Почтовый адрес, индекс, веб сайт, телефон и адрес электронной почты организации	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а <a href="http://www.niipp.ru/">http://www.niipp.ru/</a> 8 (3822) 555 089 <a href="mailto:niipp@niipp.ru">niipp@niipp.ru</a>
Полное наименование организации	Акционерное общество Научно- исследовательский институт полупроводниковых приборов «НИИПП»
Сокращенное наименование организации	АО «НИИПП»
Наименование подразделения	Лаборатория 41
Должность	Начальник лаборатории

**Список основных публикаций** официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

- 1) Ayzenshtat Gennadiy. The formation of amplitude spectra in X-ray pixel detectors made of gallium arsenide/ Prokopiev Dmitriy , Baidali Sergey //Journal of X-Ray Science and Technology. –2017. – vol. 25. –№. 4. –PP. 585-595
- 2) Ayzenshtat, G. I. Transient processes in the GaAs-based microwave-pin-diodes / G. I. Ayzenshtat , A. Y. Yushchenko, V. G. Bozhkov // Russian Physics Journal. – 2015. – Т. 57. – №. 12. – С. 1627-1633.
- 3) Ayzenshtat, G. I. A method for determining the ambipolar diffusion length and carrier lifetime in GaAs pin diodes / G. I. Ayzenshtat, A.Y. Yushchenko //Instruments and Experimental Techniques. – 2015. – Т. 58. – №. 2. – С. 279-282.
- 4) Vorobiev, A. P. A matrix gallium-arsenide detector for roentgenography. Biomedical Engineering / A. P. Vorobiev, S. N. Golovnya, S.A.Gorokhov, V.V. Parakhin, M. K. Polkovnikov, G. I. Ayzenshtat // Biomedical Engineering. – 2013. – Т. 46. – №. 5. – С. 194.
- 5) Ющенко А.Ю. Контактное устройство для зондовых измерений СВЧ нитридгаллиевых усилителей в импульсном режиме/ Г.И. Айзенштат, А.А. Пласкеев и др.// Электронная техника. сер.1, СВЧ-техника. – 2015. – Вып.1(534). – С.40-45
- 6) Bezruk, A. V. The microwave power limiter based on pin-diodes for the frequency range of 100–110 GHz in form of waveguide MIC / A. V. Bezruk, A. Y. Yushchenko, G. I. Ayzenshtat, V. G. Bozhkov, V. I. Perfiliev, // Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 23rd International Crimean Conference. – IEEE. – 2013. – С. 74-75.
- 7) Yushchenko, A. Y. Multifunction monolithic GaAs pin-diode core chip for x-band aesa T/R modules / A. Y. Yushchenko, G. I. Ayzenshtat, E. A. Monastirev, V. G. Bozhkov, A. I. Ivashenko, A. V. Bezruk // Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 23rd International Crimean Conference.– 2013 – IEEE, 2013. – С. 72-73.

- 8) Айзенштат, Г. И. Прямое сопротивление потерь в СВЧ рпн-диодах на арсениде галлия / Г. И. Айзенштат, А. Ю. Ющенко, В. Г. Божков, А. В. Безрук // Электронная промышленность. – 2014. № 1. – С. 45–55.
- 9) Безрук, А. В. Волноводная монолитная интегральная схема ограничителя свч-мощности на основе рпн-диодов для 3-мм диапазона длин волн / А. В. Безрук, А. Ю. Ющенко, Г. И. Айзенштат, В. Г. Божков, В. И. Перфильев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2013. – Т. 56. – №. 8-3. – С. 174-176.

Официальный оппонент  
доктор технических наук



Айзенштат Г. И.

Сведения верны.

Ученый секретарь НТС АО «НИИПП»



Васильев А.В.

